

Кремниевый Finger PIN фотодетекторный чип 4.980×3.820 мм — техническое описание

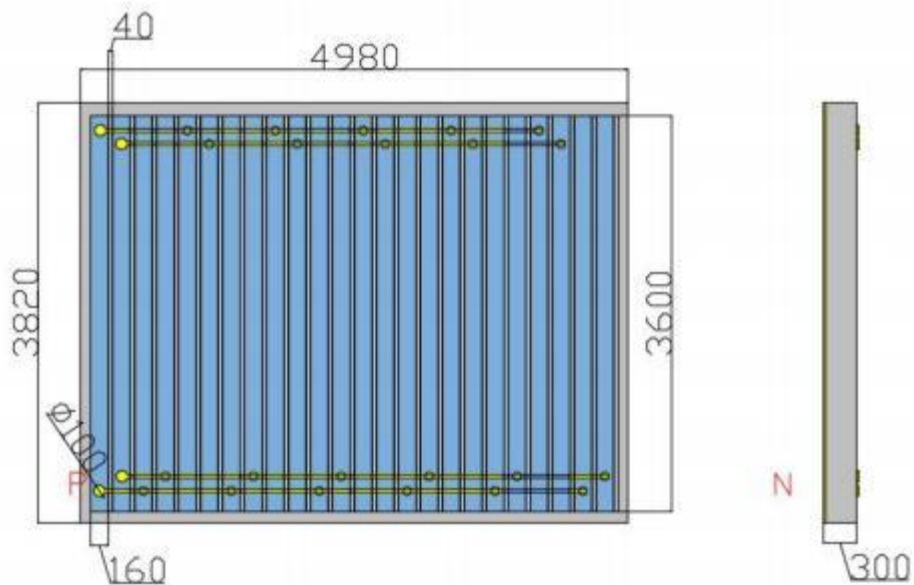
P/N : WS81-01C

Особенности

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод;
электроды: задняя сторона
(катод) — Au, верхняя сторона
(анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	160 × 3600 × 24 (шт.)			мкм
Ширина чипа	3820 ± 30			мкм
Длина чипа	4980 ± 30			мкм
Высота чипа	275	300	325	мкм
Размер контактной площадки	90	100	110	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100μA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V				нА
Рабочий диапазон длин волн	λ					нм
Емкость	Cj	VR=5V, f=1MHz				пФ